

**Подсекция
ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ - Ауд. Конф. зал ЦКП**

Определение степени окисления кремния и содержания кластеров кремния в пленках SiO_x методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии
Садчиков А.С., Парина Е.В.

Влияние нанокристаллизации пленок $\alpha\text{-Si:H}$, SiO и Si_3N_4 на их электрофизические свойства
Шулейко Д.В.

Фотопроводимость нанокристаллического оксида индия
Ситников И.А., Ильин А.С.

Электронно-лучевая эпитаксия слоев SiC и твердых растворов на его основе $(\text{SiC})_{1-x}(\text{AlN})_x$
Касумов З.К.

Исследование лазерно-индуцированного разогрева кремниевых нанонитей методом спектроскопии комбинационного рассеяния света
Родичкина С.П.

Фото- и термостимулированная проводимость сульфоселенида кадмия, легированных рубидием
Билалов А.Б.

Формирование наночастиц кремния при абляции под действием фемтосекундных лазерных импульсов в атмосферах воздуха и гелия
Кашаев Ф.В.

Метод оценки положения единичного ловушечного заряда в оксидном слое наноразмерного МОП транзистора
Худайбергенов Т.А., Сапаров Х., Матякубов Х., Атамуратов Т.А.

Кремниевый нанопровод как основа высокочувствительных полевых и зарядовых сенсоров
Божьев И.В., Ржевский А.В., Корс А.Ю., Преснов Д.Е., Крупенин В.А.

Чувствительность фотолуминесцентных свойств кремниевых нанонитей к их молекулярному окружению
Георгобиани В.А.

Структурные и оптические свойства нанокристаллов кремния и карбида кремния, полученных прямым ионным осаждением
Федоренко А.А.